

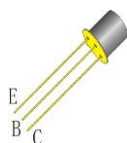
3CK110 型硅 PNP 高频小功率开关晶体管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 A3-01B 型金属封装和 SMD-0.2、UB 型金属陶瓷封装。

器件具有特征频率高、开关时间小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。

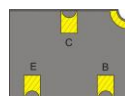
器件的静电放电敏感度为 4000V，A3-01B 典型重量 0.35g，SMD-0.2 典型重量 0.45g，UB 典型重量 0.04g。



A3-01B 型



SMD-0.2 型



UB 型

注：SMD-0.2 封装产品型号后缀加“U”标识，UB 封装产品型号后缀加“UB”标识。

2、质量等级及执行标准

G、G+级：QJ/01RBJ022 (A3-01B)，Q/RBJ1001QZ (SMD-0.2，UB 型)，QZJ840611。

A3-01B 型：JCT 级增长 (JCT/K)：Q/RBJ22002-2003，GJB33A-1997；

JP、JT、JCT：ZZR-QJ/01RBJ022-1998，GJB33A-1997；

JY1 级增长 (JY1/K)：ZZR(Z)-Q/RBJ22006-2007，GJB33A-1997；

CAST：CASTPS10/164 A-2010，GJB33A-1997。

SAST：SASTYPS0202/0015-2015，GJB33A-1997。

YA、YB、YC：Q/QJA 20104/9-2017，Q/QJA 20104A-2017。

SMD-0.2、UB 型：JP、JT、JCT 级，Q/RBJ 21414-2020，GJB33A-1997。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{tot1}}^{\text{a}}$ mW	$P_{\text{tot2}}^{\text{b}}$ mW	I_{CM} mA	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	$T_{\text{stg}} , T_{\text{j}}$ °C
3CK110A	300	1000	50	-20	-15	-4	-55~175
3CK110B				-35	-30		
3CK110C				-50	-45		
3CK110D				-20	-15		
3CK110E				-35	-30		
$^{\text{a}}$ P_{tot1} 为 $T_{\text{A}}=25^{\circ}\text{C}$ ，不加散热片时的最大额定功率； $T_{\text{A}}>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 $2.0\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。 $^{\text{b}}$ P_{tot2} 为 $T_{\text{C}}=25^{\circ}\text{C}$ 时的最大额定功率； $T_{\text{C}}>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 $6.7\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。							

4、主要电特性

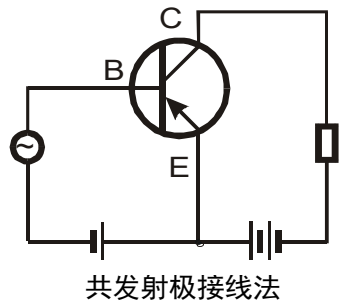
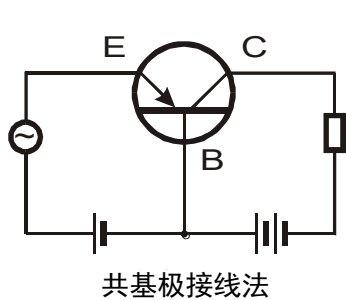
主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

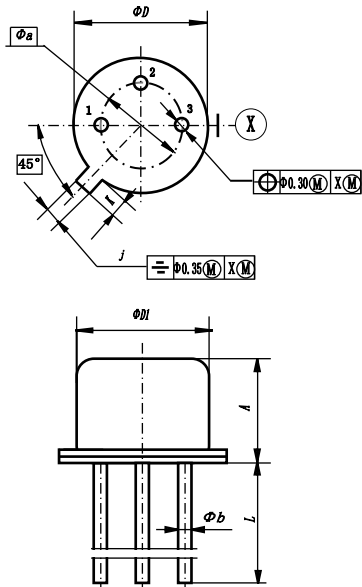
参 数		数 值			单 位
符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
$V_{(BR)CBO}$	$I_C=0.1\text{mA}$	-20	—	—	V
$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.1\text{mA}$	-15	—	—	V
$V_{(BR)EBO}$	$I_E=0.1\text{mA}$	-4	—	—	V
I_{CBO}	$V_{CB}=-10\text{V}$	—	0.02	0.2	μA
I_{CEO}	$V_{CE}=-10\text{V}$	—	0.02	0.2	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=-3\text{V}$	—	0.02	0.2	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=30\text{mA}$	25	—	180	—
$V_{BE(sat)}$	$I_C=30\text{mA}, I_B=3\text{mA}$	—	-0.80	-0.95	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=30\text{mA}, I_B=3\text{mA}$	—	-0.1	-0.3	V
f_T	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=30\text{MHz}$	150	250	—	MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	4	5	pF
t_{on}	$I_C=30\text{mA}, I_B=3\text{mA}$	—	20	50	ns
t_{off}	3CK110A~C	—	90	110	ns
	3CK110D、		50	60	

5、典型电路应用图

器件在电子线路中主要有两种接线法，如图所示：



6、外形尺寸



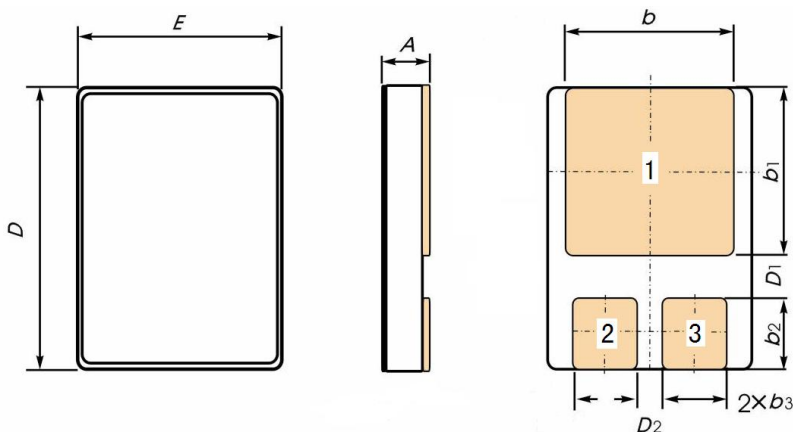
单位为毫米

尺 寸 符号	数 值		
	最小值	典型值	最大值
A	4.32	—	5.33
Φa	—	2.54	—
Φb	0.407	—	0.508
ΦD	5.31	—	5.84
ΦD_1	4.53	—	4.95
j	0.92	1.04	1.16
K	0.51	—	1.21
L	12.5	—	25.0

引出端极性：1—发射极，2—基极，3—集电极

A3-01B 外形尺寸

单位为毫米

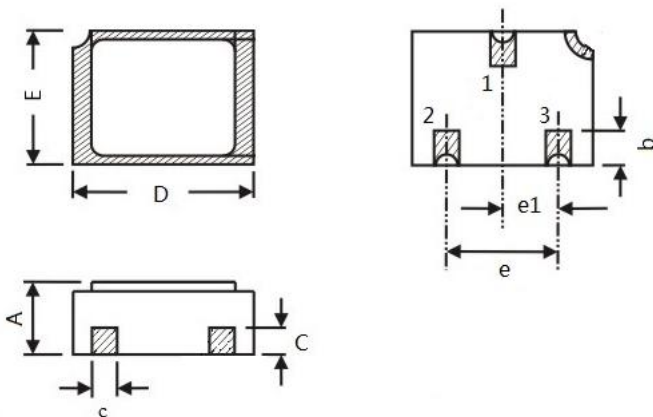


尺寸符号	数值	
	最 小 值	最 大 值
A	2.41	3.34
b	4.85	5.45
b ₁	4.40	5.15
b ₂	1.75	2.15
b ₃	1.85	2.25
D	7.77	8.13
D ₁	0.50	—
D ₂	0.60	—
E	5.23	5.64

引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

SMD-0.2 外形尺寸

单位为毫米



尺寸符号	数 值	
	最小值	最大值
A	1.12	1.47
b	0.56	0.96
C	0.43	0.89
c	0.35	0.67
D	2.82	3.35
E	2.16	2.74
e	1.76	2.07
e ₁	0.85	1.02

引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

UB 外形尺寸

7、使用和维护

7.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。

A3-01B 型封装，引出端直径 0.407mm~0.508mm。在安装、测试等过程中不允许多次折弯和施应力，否则易造成引脚折断或玻璃绝缘子裂缝，影响其密封性。SMD-0.2、UB 型金属陶瓷封装，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成陶瓷金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

7.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。